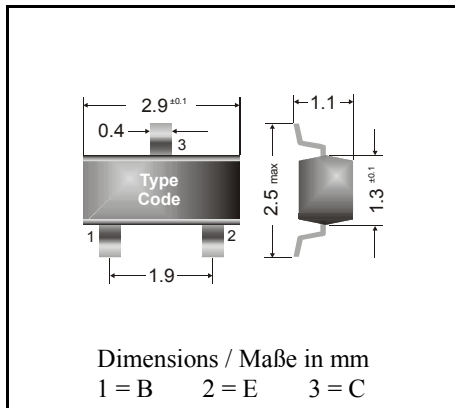


PNP

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors

Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

PNP



Power dissipation – Verlustleistung 250 mW

Plastic case SOT-23
Kunststoffgehäuse (TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca. 0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

			BSS 63
Collector-Emitter-voltage	B open	- V_{CE0}	100 V
Collector-Base-voltage	E open	- V_{CB0}	110 V
Emitter-Base-voltage	C open	- V_{EB0}	6 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	250 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I_C	100 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	100 mA
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		- I_{BM}	100 mA
Junction temp. – Sperrschichttemperatur		T_j	150 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150 °C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

	Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom			
$I_E = 0, - V_{CB} = 90 \text{ V}$	- I_{CB0}	–	100 nA
$I_E = 0, - V_{CB} = 90 \text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	- I_{CB0}	–	50 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom			
$I_C = 0, - V_{EB} = 6 \text{ V}$	- I_{EB0}	–	100 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. ¹⁾			
- $I_C = 25 \text{ mA}, - I_B = 2.5 \text{ mA}$	- $V_{CE\text{sat}}$	–	250 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾			
- $I_C = 25 \text{ mA}, - I_B = 2.5 \text{ mA}$	- $V_{BE\text{sat}}$	–	900 mV

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾				
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$	h_{FE}	30	–	–
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 25\text{ mA}$	h_{FE}	30	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 25\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	f_T	50 MHz	85 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{CB0}	–	3 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}		420 K/W ²⁾
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		BSS 64		

Marking - Stempelung

BSS 63 = BM

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß